

Title (en)

SEMICONDUCTOR MEMORY CELL MARGIN TEST CIRCUIT.

Title (de)

TESTSCHALTUNG FÜR DEN SPIELRAUM VON HALBLEITERSPEICHERZELLEN.

Title (fr)

CIRCUIT DE TEST DE CELLULES DE MARGE D'UNE MEMOIRE A SEMI-CONDUCTEUR.

Publication

EP 0070822 A1 19830209 (EN)

Application

EP 81901599 A 19810202

Priority

US 8100136 W 19810202

Abstract (en)

[origin: WO8202792A1] A margin test circuit (10) is provided for a semiconductor memory circuit having a plurality of memory cells (16). Each of the memory cells (16) in one row of cells (16) are interconnected to a word line (14). The margin test circuit (10) further includes a row decoder/driver (12) which receives a variable voltage ($V_{ucc>u}$ *) for changing the signal level stored within a memory cell (16) to thereby determine the marginal voltage level at which the memory cell (16) will maintain storage of a signal level. The variable voltage ($V_{ucc>u}$ *) is the semiconductor memory circuit main supply source ($V_{ucc>u}$) in normal operation but can be forced to a different voltage during the margin test.

Abstract (fr)

Circuit de test de marge (10) pour une memoire a semi-conducteur ayant une pluralite de cellules de memoire (16). Chacune des cellules de memoire (16) d'une rangee de cellules (16) est connectee a une ligne de mots (14). Le circuit de test de marge (10) comprend egalement un decodeur/organe de commande (12) qui recoit une tension variable (V_{cc}^*) afin de modifier le niveau de signal stocke dans une cellule de memoire (16) pour determiner ainsi le niveau de tension de marge auquel la cellule de memoire (16) conserve le stockage d'un niveau de signal. La tension variable (V_{cc}^*) est la source d'alimentation principale (V_{cc}) de la memoire a semi-conducteur en fonctionnement normal mais peut etre portee a une autre tension au cours du test de marge.

IPC 1-7

G11C 11/40

IPC 8 full level

G11C 29/50 (2006.01)

CPC (source: EP)

G11C 29/50 (2013.01); **G06F 2201/81** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR GB LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 8202792 A1 19820819; EP 0070822 A1 19830209

DOCDB simple family (application)

US 8100136 W 19810202; EP 81901599 A 19810202